

中国科学院半导体研究所

简介

1956年，在我国十二年科学技术发展远景规划中，半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地

，国家于1960年9月6日在北京成立[中国科学院半导体研究所](http://www.china-nengyuan.com/baike/8652.html)

（以下简称半导体所），开启了中国半导体科学技术的发展之路。

半导体所拥有两个国家级研究中心—国家光电子工艺中心、光电子器件国家工程研究中心；两个全国重点实验室—光电子材料与器件全国重点实验室、半导体芯片物理与技术全国重点实验室；此外，还设有新质半导体激光重点学科与技术研究中心、纳米光电子实验室、人工智能与高速电路实验室、光电系统实验室、全固态光源实验室、宽禁带半导体研发中心、光电子工程中心、半导体集成技术工程研究中心和元器件检测中心。

半导体所现有职工700余名。其中科技人员约600余名。包括中国科学院院士8名，中国工程院院士1名，高层次引进人才计划50余人，国家杰出青年科学基金获得者20人，“百千万人才工程”入选者10人，其中黄昆院士荣获2001年国家最高科学技术奖。设有3个博士后流动站，5个一级学科博士培养点，2个专业学位授权点。

半导体所高度重视国内外交流合作，与地方政府、科研机构、大学和企业等共建了近40个联合实验室，积极为企业和区域经济社会发展服务。积极开展多层次、全方位的国际学术交流与合作，成绩显著，获得“国际科技合作基地”认定。以自主知识产权的专利和专有技术投资，融合社会资本建立了10余家高技术企业，并实施科研成果转化为现实生产力，已初步形成产业化、商品化规模。

半导体所秉承“两个卓越”和“三个推动”的办所理念，奋斗不息，勇攀高峰，取得了快速发展，研究所现已发展成为集半导体物理、材料、器件研究及其系统集成应用于一体的国家级半导体科学技术的综合性研究机构。

半导体所的中长期发展战略目标是：开展与国家发展密切相关的、世界科技前沿的基础性、前瞻性、战略性科技创新活动，为发展我国的高新技术提供源源不断的动力；以国家重大需求为导向，开展前沿基础和应用技术研究，为国家科技发展提供支撑，并为相关行业的技术进步作出贡献；吸引、聚集和培养国际一流人才；建立具有国际先进水平的、开放的实验研究和测试平台，实现科技创新能力的跨越和持续发展，成为引领我国半导体科学技术发展的火车头。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/8652.html>